

2SC2267H

シリコン NPN 三重拡散形

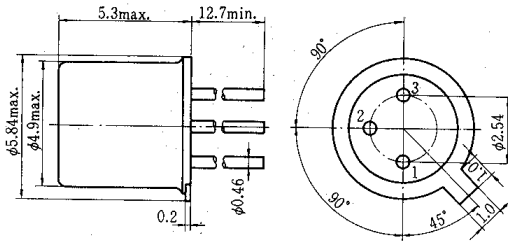
高電圧スイッチング用

2SA1024[Ⓜ] とコンプリメンタリペア

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

HIGH VOLTAGE SWITCHING

Complementary pair with 2SA1024[Ⓜ]



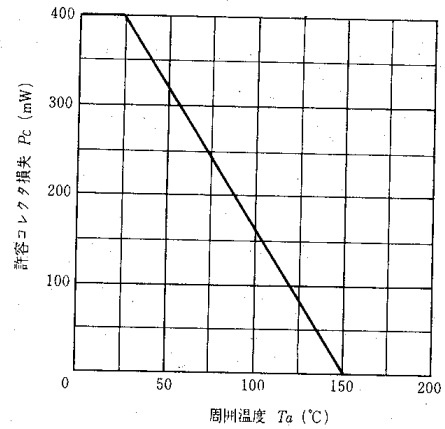
1. エミッタ: Emitter
 2. ベース: Base
 3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)

(JEDEC TO-18)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| 項 目 | Symbol | 2SC2267 [Ⓜ] | Unit |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| コレクタ・ベース電圧 | V_{CBO} | 400 | V |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V_{CEO} | 360 | V |
| エミッタ・ベース電圧 | V_{EBO} | 5 | V |
| コレクタ電流 | I_C | 100 | mA |
| せん頭コレクタ電流 | $i_{C(\text{peak})}$ | 500 | mA |
| 許容コレクタ損失 | P_C | 400 | mW |
| 接合部温度 | T_j | 150 | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度 | T_{stg} | -55 ~ +150 | $^\circ\text{C}$ |

許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| 項 目 | Symbol | Test Condition | min | typ | max | Unit |
|---------------|----------------------|---|-----|-----|-----|---------------|
| コレクタ・ベース破壊電圧 | $V_{(BR)CBO}$ | $I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$ | 400 | — | — | V |
| コレクタ・エミッタ破壊電圧 | $V_{(BR)CEO}$ | $I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$ | 360 | — | — | V |
| エミッタ・ベース破壊電圧 | $V_{(BR)EBO}$ | $I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$ | 5 | — | — | V |
| コレクタ遮断電流 | I_{CEO} | $V_{CE}=250\text{V}, R_{BE}=\infty$ | — | — | 1.0 | μA |
| 直流電流増幅率 | h_{FE} | $V_{CE}=20\text{V}, I_C=20\text{mA}$ | 35 | — | 200 | |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | $V_{CE(\text{sat})}$ | $I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$ | — | 0.2 | 1.0 | V |
| ベース・エミッタ飽和電圧 | $V_{BE(\text{sat})}$ | $I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$ | — | — | 1.3 | V |
| 利得帯域幅積 | f_T | $V_{CE}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}$ | 40 | 70 | — | MHz |
| コレクタ出力容量 | C_{ob} | $V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$ | — | 4.0 | 10 | pF |